

## OBSAH

Předmluva .....	5
Seznam použitých znaků .....	13
<b>1. Základy činnosti polovodičů .....</b>	<b>21</b>
1.1 Úvodní poznatky o polovodičích .....	21
1.2 Průtok proudu polovodiči .....	24
1.3 Přechod P — N .....	26
1.4 Plošný transistor .....	30
1.5 Vlivy vysoké teploty na transistory .....	32
1.6 Činnost výkonových transistorů .....	34
1.7 Činnost transistorů při vysokých kmitočtech .....	35
1.8 Porovnání hrotových a plošných transistorů .....	35
1.9 Použití jiných polovodičů pro přechody .....	36
1.10 Příklady k řešení .....	37
1.11 Literatura .....	37
<b>2. Tvary, druhy a charakteristiky transistorů .....</b>	<b>39</b>
2.1 Hrotové transistory .....	39
2.2 Plošné transistory .....	42
<b>3. Transistory v nízkofrekvenčních obvodech .....</b>	<b>46</b>
3.1 Transistor jako „neznámý čtyřpól“ .....	46
3.2 Náhradní obvod tvaru převráceného II .....	47
3.3 Náhradní obvod ve tvaru článku T s jedním vnitřním zdrojem napětí .....	47
3.4 Náhradní obvod ve tvaru článku T s jedním vnitřním zdrojem proudu .....	47
3.5 Náhradní obvod pro zapojení s uzemněným emitem s vnitřním zdrojem napětí .....	49
3.6 Náhradní obvod pro zapojení s uzemněným emitem s vnitřním zdrojem proudu .....	49
3.7 Náhradní obvody pro zapojení s uzemněným kolektorem .....	50
3.8 Odvození parametrů transistorů z charakteristik .....	50
3.9 Změny parametrů při změnách pracovního bodu .....	52
3.10 Změny parametrů s teplotou .....	55
3.11 Příklady k řešení .....	58
3.12 Literatura .....	58
<b>4. Hlavní principy transistorového zesilovače .....</b>	<b>59</b>
4.1 Úvod .....	59
4.2 Základní zapojení transistorů .....	59
4.3 Vlastnosti jednostupňových zesilovačů .....	59
4.4 Zapojení s uzemněnou basí: přesné vzorce .....	61
4.5 Zapojení s uzemněnou basí: přibližné vzorce pro plošné transistory .....	63
4.6 Zapojení s uzemněným emitorem: přesné vzorce .....	64
4.7 Zapojení s uzemněným kolektorem: přesné vzorce .....	67
4.8 Charakteristiky plošných transistorů .....	70
4.9 Kriteria stability .....	75
4.10 Energetický zisk a celkové výkonové zesílení .....	80
4.11 Celkové výkonové zesílení u tří základních zapojení transistorů .....	81
4.12 Příklady k řešení .....	83
4.13 Literatura .....	83

<b>5. Několikastupňové zesilovače s plošnými transistory</b>	<b>84</b>
5.1 Úvod	84
5.2 Zesilovače s vazbou <i>RC</i>	84
5.3 Zesilovače s transformátorovou vazbou	93
5.4 Příklady k řešení	97
<b>6. Stabilizace pracovního bodu transistorů</b>	<b>98</b>
6.1 Požadavky na provozní napětí transistorů	98
6.2 Obvyklé způsoby napájení	98
6.3 Napájení z jediné baterie	101
6.4 Problémy stability několikastupňových zesilovačů	105
6.5 Kaskádní transistorové zesilovače s transistory napájenými v serii	106
6.6 Vztahy stejnosměrných proudů v kaskádních transistorových zesilovačích	107
6.7 Jiná zapojení kaskádních transistorových zesilovačů	109
6.8 Kaskádní transistorové zesilovače s dvojicínným výstupem	112
6.9 Výpočet pracovních obvodů kaskádních transistorových zesilovačů	112
6.10 Příklady skutečného provedení kaskádních transistorových zesilovačů	116
6.11 Kaskádní transistorové zesilovače se zpětnou vazbou	118
6.12 Transformátorová vazba u kaskádních transistorových zesilovačů se seriovou stabilisací	119
6.13 Diferenciální výpočet	121
6.14 Příklady k řešení	125
<b>7. Výkonové zesilovače</b>	<b>127</b>
7.1 Úvod	127
7.2 Způsob činnosti	127
7.3 Volba vhodného zapojení	129
7.4 Zesilovače třídy A	130
7.5 Zesilovače třídy B	138
7.6 Budíci stupen	144
7.7 Činnost transistorových zesilovačů při vysokých teplotách	145
7.8 Příklady k řešení	149
7.9 Literatura	149
<b>8. Stejnosměrné zesilovače</b>	<b>150</b>
8.1 Zesilovače s přímou vazbou	150
8.2 Základní vztahy	151
8.3 Samovolné změny	153
8.4 Teplotní kompenzace stejnosměrných zesilovačů	154
8.5 Teplotní kompenzace nelineárními členy	160
8.6 Pracovní vlastnosti teplotně kompensovaného stejnosměrného zesilovače	162
8.7 Stabilita napájecích zdrojů a hlavní rysy jejich konstrukce	164
8.8 Příklady k řešení	164
<b>9. Transistory jako prvky vysokofrekvenčních obvodů</b>	<b>166</b>
9.1 Platnost nízkofrekvenčních náhradních obvodů pro vysoké kmitočty	166
9.2 Náhradní obvody transistoru při vysokých kmitočtech	168
9.3 Změny veličiny $\alpha$ a činitele $b$	171
9.4 Změny ostatních parametrů náhradního obvodu	177
9.5 Příklady k řešení	180
9.6 Literatura	181
<b>10. Základy vysokofrekvenčních transistorových zesilovačů</b>	<b>182</b>
10.1 Transistorový zesilovač s uzemněnou basi	182
10.2 Zesilovač s uzemněným emitorem	190
10.3 Zesilovač s uzemněným kolektorem	193
10.4 Výkonové zesílení při různé šířce pásma	196
10.5 Kriteria stability	201
10.6 Příklady k řešení	204
10.7 Literatura	204

<b>11.</b>	<i>Navrhování vysokofrekvenčních transistorových zesilovačů</i>	205
11.1	Úzkopásmový laděný zesilovač	205
11.2	Širokopásmové laděné zesilovače	220
11.3	Příklady k řešení	223
11.4	Literatura	223
<b>12.</b>	<i>Širokopásmové transistorové zesilovače</i>	224
12.1	Úvod	224
12.2	Zapojení jednotlivých stupňů několikastupňového zesilovače	225
12.3	Nízkofrekvenční širokopásmové zesilovače	226
12.4	Vysokofrekvenční širokopásmové zesilovače	228
12.5	Příklady k řešení	237
12.6	Literatura	237
<b>13.</b>	<i>Oscilátory</i>	238
13.1	Úvod	238
13.2	Oscilátory se zápornou impedancí	239
13.3	Oscilátory se zpětnou vazbou	241
13.4	Krystalové oscilátory	245
13.5	Otzázy lineárnosti	245
13.6	Transistorové multivibrátory	247
13.7	Příklady k řešení	250
13.8	Literatura	250
<b>14.</b>	<i>Navrhování transistorových obvodů na základě principu duality</i>	251
14.1	Úvod	251
14.2	Dualita elektrických obvodů	251
14.3	Dualita elektronkových a transistorových obvodů	255
14.4	Příklady duálních obvodů	259
14.5	Příklady k řešení	260
14.6	Odkazy na literaturu	260
<b>15.</b>	<i>Řešení transistorových obvodů maticovým počtem</i>	261
15.1	Úvod	261
15.2	Řešení technických problémů použitím čtyřpólů	261
15.3	Transistor jako čtyřpól	261
15.4	Způsoby maticových výpočtů	262
15.5	Uzavřený čtyřpól	278
15.6	Použití maticových výpočtů	280
15.7	Tabulky	292
15.8	Příklady k řešení	294
15.9	Literatura	297
<b>16.</b>	<i>Zesilovače se zpětnou vazbou</i>	298
16.1	Úvod	298
16.2	Rozdíly mezi transistory a elektronkami	298
16.3	Základy teorie zpětné vazby	298
16.4	Parametry transistorů při vysokých kmitočtech	303
16.5	Typické druhy zapojení	304
16.6	Základní teorie	306
16.7	Obecná teorie zpětné vazby v transistorových zesilovačích	306
16.8	Stabilita	308
16.9	Stanovení impedance	312
16.10	Příklady k řešení	317
16.11	Literatura	318
<b>17.</b>	<i>Rozbor činnosti transistorů při přechodných jevech</i>	319
17.1	Úvod	319
17.2	Fyzikální problémy	319
17.3	Řešení difusní rovnice	322
17.4	Náhradní obvod plošného transistoru při slabých signálech	328
17.5	Všeobecné poznatky o obvodech	336

17.6 Přechodné jevy při silných signálech . . . . .	339
17.7 Příklady k řešení . . . . .	341
17.8 Literatura . . . . .	341
<b>18. Činnost transistorů při silných signálech . . . . .</b>	<b>343</b>
18.1 Úvod . . . . .	343
18.2 Grafické řešení obvodu při silných signálech . . . . .	344
18.3 Dynamický proudový zesilovací činitel . . . . .	346
18.4 Náhradní obvod při silných signálech; pasivní obvod . . . . .	347
18.5 Náhradní obvod při silných signálech; dynamický obvod . . . . .	349
18.6 Vliv vodivé dráhy . . . . .	351
18.7 Příklady k řešení . . . . .	353
18.8 Literatura . . . . .	354
<b>19. Obvody počítacích strojů . . . . .</b>	<b>355</b>
19.1 Úvod . . . . .	355
19.2 Elektronické analogony . . . . .	356
19.3 Číslicové počítací stroje . . . . .	363
19.4 Spouštěcí obvody; zesilovače se zpětnou vazbou . . . . .	366
19.5 Příklady k řešení . . . . .	374
19.6 Literatura . . . . .	375
<b>20. Šum transistorů . . . . .</b>	<b>377</b>
20.1 Povaha šumu transistorů . . . . .	377
20.2 Šum transistorů při chodu naprázdně . . . . .	377
20.3 Šumová čísla transistorů . . . . .	378
20.4 Poměr signálu k šumu u transistorového zesilovače . . . . .	380
20.5 Vliv odporu zdroje na šumové číslo . . . . .	381
20.6 Šumové číslo druhého stupně zesilovače . . . . .	383
20.7 Měření šumu transistorů . . . . .	384
20.8 Příklady k řešení . . . . .	387
20.9 Literatura . . . . .	387
<b>21. Přehled ostatních polovodičových elektronek . . . . .</b>	<b>388</b>
21.1 Diody . . . . .	388
21.2 Jiné prvky s jedním přechodem . . . . .	398
21.3 Transistory s větším počtem elektrod . . . . .	401
21.4 Polovodičové prvky ovládané elektrickým polem . . . . .	406
21.5 Polovodič s fotoelektrickými vlastnostmi . . . . .	407
21.6 Literatura . . . . .	410
<b>22. Měření parametrů při slabých signálech . . . . .</b>	<b>412</b>
22.1 Úvod . . . . .	412
22.2 Měření veličin $\alpha$ , $a$ a $b$ při nízkých kmitočtech . . . . .	413
22.3 Měření veličin $r_k$ a $(r_k - r_m)$ při nízkých kmitočtech . . . . .	416
22.4 Měření veličin $r_b$ a $r_e$ při nízkém kmitočtu . . . . .	418
22.5 Universální zařízení k měření parametrů při nízkých kmitočtech . . . . .	422
22.6 Obtíže měření při vyšších kmitočtech . . . . .	422
22.7 Měření mezního kmitočtu pro veličinu $\alpha$ . . . . .	423
22.8 Měření kapacity kolektoru . . . . .	425
22.9 Zobrazování charakteristik osciloskopem . . . . .	428
22.10 Příklady k řešení . . . . .	432
22.11 Literatura . . . . .	432
<b>Dodataky . . . . .</b>	<b>433</b>
I. Maticový počet . . . . .	433
II. Vysvětlení pojmu . . . . .	437
III. Přehled literatury . . . . .	441
<b>Rejstřík . . . . .</b>	<b>449</b>